論文

マイクロギャップ放電に伴う過渡電圧・電流立上り波形の12 GHz 帯域 測定と電極間電界強度特性

川又 $憲^{\dagger a}$ 嶺岸 茂樹^{$\dagger \dagger$} 芳賀 昭^{$\dagger \dagger$} 藤原 修^{$\dagger \dagger \dagger$}

Measurement of Voltage and Current Waveforms Using 12 GHz Measurement System and Breakdown Field Strength due to Micro Gap Discharge

Ken KAWAMATA^{†a)}, Shigeki MINEGISHI^{††}, Akira HAGA^{††}, and Osamu FUJIWARA^{†††}

あらまし ESD(静電気放電)あるいは電気接点放電などのうち,おおよそ1000V以下程度の比較的に低い 電圧によって生じるマイクロギャップ放電に着目して実験的な検討を行った.実験は,放電開始時の急しゅんな 過渡電圧及び電流の立上り特性について時間領域にて測定した.更に,測定により得られた立上り時間特性の過 渡要因を考察するため,放電時のギャップ長特性について測定を行い,放電開始時の電極間電界強度を求めた. 測定のための実験系は,マイクロギャップ放電に伴う過渡変動が非常に急しゅんであることを考慮して分布定数 系で構成し,放電電極部分の周波数帯域を12 GHz まで吟味し,広帯域での測定を行った.実験の結果,放電電 E 600 V 以下においては,電圧及び電流の立上り時間は32 ps 以下と12 GHz の帯域に迫る超高速現象であるこ とを確認した.また,放電開始時のギャップ間電界強度は,放電電圧が450 V から低下するに従いギャップ間の 電界値は上昇し,放電電圧約330 V におけるギャップ間の電界は8×10⁷ [V/m] に達することを確認した. キーワード ESD,電気接点放電,立上り時間,分布定数システム,ギャップ長,放電電界

1. まえがき

ESD(静電気放電)あるいは電気接点間の放電に 伴って,インパルス性の過渡電圧・電流変動が生じ, 広い周波数範囲に及ぶ電磁雑音源となる.一方,近年 の電気電子システムは情報伝達信号のディジタル化が 進み,伝達信号の低レベル化によりESDなどのイン パルス性の電磁雑音波による影響を受けやすい傾向に ある.このため放電に伴う電磁雑音はEMC環境電磁 工学上の重要な問題となっている[1].

このような問題を踏まえ,本田らは,ESD による インパルス性の電磁雑音が電子計算機に与える影響に ついて報告し, ESD 雑音の脅威を早くから訴えている [2]~[4].また,藤原らは,ESD によって発生する 電磁界の解析及び定量化に取り組み,ESD に伴う電磁 界変動の特異性について多角的に解明している [5],[6].

ESD に伴う電磁雑音特性の代表的な特異性として, 比較的に低い電圧(ここでは,おおよそ1kV以下を低 電圧 ESD と称する)の方が,電磁雑音の干渉レベル が大きい場合がしばしばあり,また更に発生電磁雑音 の周波数帯域がマイクロ波帯に及ぶ場合があるなどが 報告されている[7],[8].これらの要因として,低電圧 ESD においては,放電時の電極間隔がマイクロメー タオーダと非常に短く,よって放電発生時の電極間電 界値が極端に増加することに起因すると考えられてい る.また,非常に高い電極間の電界に加速された電荷 の移動によって,電圧・電流の過渡変動はピコセコン ドオーダの超高速な時間変化を示し、マイクロ波領域 に及ぶ高周波数域のスペクトル成分を含むと考えられ ている [9]. しかし, これらは非常に高速かつ広帯域の 現象であるため,時間領域におけるリアルタイム測定 は難しく、これまでは解析的アプローチや周波数領域

[†]八戶工業大学工学部,八戶市 Faculty of Engineering, Hachinohe Inst. of Tech., 88–1 Obiraki Myo, Hachinohe-shi, 031–8501 Japan
^{††}東北学院大学工学部,多賀城市 Faculty of Engineering, Tohoku Gakuin University, 1–13–1 Chuo, Tagajo-shi, 985–8537 Japan
^{†††}名古屋工業大学工学部,名古屋市

Faculty of Engineering, Nagoya Inst. of Tech., Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya-shi, 466–8555 Japan

a) E-mail: kawamata@hi-tech.ac.jp

測定による実験データをもとにした検証が主流となっていた[10]~[12].

そこで筆者らは,近年の高速ディジタルオシロス コープの登場により可能となってきた GHz 帯域での 時間領域測定を実現させるため,分布定数系により構 成した放電実験回路を用いて 6 GHz 帯域までの ESD 現象測定及び検討を行ってきた [13]~[16].しかし,観 測された過渡変動時間は約70 ps 以下と 6 GHz の帯域 に迫るものであった.そこで今回は,実験システムの 帯域を 12 GHz まで吟味した新たなシステムを構築し, 低電圧 ESD に伴う過渡電圧・電流立上り時間特性に ついて測定を行った.更に,放電開始時のギャップ 長 特性について測定を行い,放電開始時のギャップ間電 界特性を実験的に求めた結果について述べる.

2. 12 GHz 帯域実験システムの構成

新たに構築した 12 GHz 帯域の放電実験システムの 構成を図1に示す.システムは出力電圧及び極性可変 の直流高電圧電源装置,中心導体に針電極を施した電 源側セミリジットケーブル (UT141, 最長1m~最短 0.2m), 同様に平板電極を施した負荷側セミリジット ケーブル(UT250,最長1m~最短0.2m),反射波の 到来を遅れさせるための同軸ケーブル(5D2W,3m), 更には電界センサ及び磁界センサで構成している.た だし,実験システムの外部導体部並びに両センサの外 部導体部は筐体アースとした.本実験システムは放電 によって発生する過渡現象に対して電気的に均一な伝 送路を提供し,分布定数線路に蓄えた電荷により一定 時間均-な電気エネルギーを供給した状態で,放電に 伴う過渡現象の測定を行うものである.また今回のシ ステムでは、過渡変動のセンシングに微小ループアン テナによる磁界センサ,及び微小モノポールアンテナ による電界センサを用い,高電圧で変化する分布定数 線路上の過渡変化分を非接触かつ広帯域に測定した.

次に放電電極部の詳細及び電圧・電流ピックアップ 用センサの配置を図2に示す.電極部は針電極を施し た電源側セミリジットケーブルと平板電極を施した負 荷側セミリジットケーブルにより針対平板の非対称電 極を構成している.なお,電源側針電極の先端部曲率 半径は0.1mm及び0.5mmの2種類とした.また, 負荷側平板電極の直径は1.6mmである.電流成分を ピックアップするための磁界センサは放電電極近傍に 配置し,電圧成分をピックアップする電界センサは, 電源側の充電電圧からの静電誘導を避けるため,電極





Fig. 3 Insertion loss of the coaxial electrode system. (The radius of curvature of needle electrode is 0.5 mm)

部から 3 cm 離れた負荷側へ配置した.

今回試作した分布定数系実験システムの周波数特性 を図3に示す.なお,結果は針電極の曲率半径0.5mm の場合で表しているが,曲率半径0.1mmにおいても おおむね同様の特性を示した.周波数特性は電極部 分を機械的に接触させた状態で,電源側セミリジット ケーブルから電極部を介して負荷側のセミリジット ケーブル間(図1のaからb点間)の挿入損で評価



Fig. 4 Coupling attenuation of the E-field sensor and the H-field sensor.

した.同軸電極構造による分布定数系実験システムの 挿入損は,12 GHz において約 -3 dB 程度とおおむね 良好な周波数特性を示した.次に電圧及び電流センサ の結合減衰量の周波数特性を図4に示す.図4(a)が 電圧センサの特性であり図 4(b) が電流センサの特性 である.いずれのセンサも低域部分での結合量は低下 しているが,数 GHz から 12 GHz までの高域部分に おいては,電圧センサで約-25dB程度,電流センサ で約 -20 dB 程度の結合量となっており, 電圧及び電 流の立上り部を構成する高周波数成分の測定が可能と 考えられる.また,今回の実験結果は,これら周波数 特性による補正及び電圧値あるいは電流値への換算は 行っておらず,電界成分及び磁界成分によるセンサ出 力電圧の測定値である.また,今回使用したセンサの 時間領域におけるパルス応答特性は,立上り時間34ps のステップ的な立上り波形に対して,電圧センサは約 37 ps, 電流センサは約 36 ps の立上り応答時間を示 した.

3. 電圧・電流立上り波形の測定結果

電圧・電流立上り波形の測定パラメータは電源極性 及び針電極先端部の曲率半径であり,それぞれの条件 において電源電圧を400Vから1000Vまで変化させ, 電極間隔を徐々に接近させ,放電が発生した瞬間の電



Fig. 5 Measured voltage waveforms and current waveforms due to discharging.





界センサ及び電流センサ出力波形を高速ディジタルオ シロスコープ(TEKTRONIX TDS6124C, 12 GHz, 40 GS/s)により観測した.

図 5 に電圧・電流の立上り部分に応答した両セン サの出力波形を示す.図 (a),(c) が電圧波形であり, 図 (b),(d) が電流波形である.また,図 (a),(b) が正 極の場合であり,図 (c),(d) が負極の場合である.更 に,針電極の先端部曲率半径は両図とも 0.1 mm,電 源電圧は 800 V の結果である.なお,本システムでは 放電開始直後の電圧・電流変動はステップ的な立上り を示すが,各センサの応答により出力波形はインパル ス的となる.今回は,両センサ出力波形の立上り応答 時間 (10 - 90%)から電圧及び電流の立上り時間を測 定した.結果を見ると,正極における電圧及び電流の 立上り時間は,約 35 ps 程度と非常に高速であること が分かる.これに対して,負極における立上り時間は 約 45 ps 程度と,正極に比べ若干立上り時間が長くな る傾向を確認した.

次に,これらの電圧・電流立上り時間と放電電圧の 関係を定量的に検討するため,立上り時間特性を求め た結果を図6に示す.図(a)は電圧立上り時間特性で あり,図(b)は電流立上り時間特性である.両図とも 横軸は放電電圧400Vから1000Vであり,縦軸は立 上り時間psである.また,それぞれのプロットは6回 から10回程度の実験による平均値である.更に図中 の網がけ部分は今回使用したオシロスコープの帯域制 限域を示している.この結果から,まず,600V以下 の放電電圧において電圧及び電流の立上り時間は約 32 ps 程度と非常に高速であることが分かる.ただし, この立上り時間についてはシステムの帯域制限域に達 しており,現象本来の立上り時間はより高速であると 予測される.次に,800 Vから1000 Vの放電電圧上 昇に伴って電圧・電流立上り時間も徐々に長くなる傾 向を示した.更に,針電極曲率半径0.1mmにおける 負極の放電条件において,電圧及び電流立上り時間は 急激に長くなり,900 Vから1000 Vの放電電圧にお いては,立上り時間は約80 ps 程度となった.

放電時ギャップ長の測定と電極間電界強度特性

これまでの結果から,放電立上り時間は 32 ps 以下 の非常に急しゅんな現象であることを確認した.これ らは前述のとおり,既に 12 GHz システムの帯域制限 による影響を受けているものと推察され,実際の現象 はより高速であることが予想される.これら実際の立 上り時間を推定する上で,放電開始時におけるギャッ プ間の電界強度を明らかにする必要がある.

そこで今回,放電開始ギャップ長を実験的に測定し, その結果から電極間電界値の算出を行った.放電開始 時の電極間電界の大きさは式(1)により求めた.

$$E = V/d \left[V/m \right] \tag{1}$$

ここで, V は放電電圧 [V], d は放電開始時のギャッ プ長 [m] である.

ギャップ長測定システムは6GHz帯域の旧型電極を 用い[16],同軸テーパ構造の針対平板電極及びディジ タルマイクロメータヘッドで構成した.実験において 電源側の針電極を施したセミリジットケーブルをマイ



クロメータヘッドにより徐々に負荷側の平板電極に接 近させ,放電が開始した瞬間のギャップ間隔を $1 \mu m$ 分解能で観測するものである.実験のパラメータはこ れまでと同様,電源極性及び針電極先端部の曲率半径 を 0.5 mm 及び 0.1 mm と変化させ,それぞれの条件 において電源電圧約 330 V から約 750 V までの放電開 始時におけるギャップ長を測定した.

図7に放電開始時のギャップ長特性を示す.図は正極におけるギャップ長特性であり, が針先端曲率半径 0.1 mm, が 0.5 mm の場合のギャップ長特性である.それぞれのプロットはいずれも 80回以上の実験による平均値である.針先端部曲率半径 0.1 mm 及び 0.5 mm とも,放電電圧約 750 V における電極間ギャップ長は約 45~50 μ m 程度あり,放電電圧の低下に伴ってギャップ間隔は短くなり,今回の最低放電電圧 326 V におけるギャップ長は両針電極とも,約 4~5 μ m 程度と非常に短いギャップ長であることが分かった.また,今回の放電電圧 750 V から 326 V の範囲においては,放電電圧とギャップ長はおおむね直線的な関係を示すことが分かった.ただし,326 V 未満の更なる低電圧領域での関係については今のところ未確認であり,今後の課題である.

次に,式(1)により放電開始時における電極間の電 界強度を求めた結果を図 8 に示す.パラメータはこれ までと同様で正極における針先端部曲率半径 0.1 mm が ,及び 0.5 mm が の場合を表している.放電開 始時の電極間における電界値は,電圧約 750 V から 約 450 V の間では約 20 × 10⁶ V/m 程度でおおむね 一定な値を示した.これに対して,電圧 400 V 以下



Fig. 8 Breakdown field characteristics at the start of the discharge.

では電界値が急激に上昇し,約 330 V における電界 は 80×10^6 V/m と非常に高い電界値を示すことが分 かった.この結果は,低電圧 ESD の方が,電磁干渉レ ベルが高い場合がある事象に対する要因の一部と考え られるが,本結果と発生電磁界強度の関係については, 今後更に検討を行い明らかにする必要があると考える.

5. む す び

1000 V 以下の比較的に低い電圧領域におけるマイ クロギャップ放電に着目し,過渡変化の立上り時間特 性及び電極間の電界強度特性の測定を行った.

その結果,放電電圧 600 V 以下においては,電圧 及び電流の立上り時間は 32 ps あるいはそれ以下と 12 GHz の帯域に迫る非常に高速な現象であることを 確認した.これらの立上り時間は放電電圧,電源極性, 更には放電電極形状により変化することを確認した. また,放電開始時のギャップ長は放電電圧に比例して おおむね直線的に変化するのに対して,電極間の電界 強度は,約 400 V 以下の放電電圧において急激に上昇 し,今回の最低放電電圧約 330 V におけるギャップ間 の電界強度は 8 × 10⁷ V/m に達することを確認した.

以上のことから,低電圧 ESD による電磁雑音波の周 波数成分はマイクロ波領域の幅広い周波数スペクトル を含み,更に,電磁干渉レベルが大きくなる可能性を 実験的に確認した.今後更に EMC の観点から,より 低い電圧領域におけるマイクロギャップ放電現象につ いて検討するとともに,これらの低電圧放電と発生電 磁雑音特性の関係についても検討を進める予定である.

文 献

- 高木 相, "EMC/EMI 関連測定とその測定技術に関する 我が国の研究開発",信学論(B-II), vol.J79-B-II, no.11, pp.718-726, Nov. 1996.
- [2] 本田昌實,川村雄克,"ESD の特徴と計算機に対する影響 (その1)",信学技報,EMCJ83-75,1983.
- [3] 本田昌實,川村雄克,"ESD の特徴と計算機に対する影響 (その2)",信学技報,EMCJ83-87,1984.
- [4] 本田昌實, "金属物体で発生する静電気放電(ESD)現象の脅威,"信学誌, vol.78, no.9, pp.849-850, Sept. 1995.
- [5] 藤原 修, "ESD のソースモデルと発生電磁界"第31 回東北大学電気通信研究所シンポジウム「放電と EMC」, pp.95-100, 1994.
- [6] 藤原 修, "ESD 現象をとらえるソースモデルと界特性,"
 信学誌, vol.78, no.9, pp.851–852, Sept. 1995.
- [7] 馬杉正男,村川一雄,桑原伸夫,雨宮不二雄,"間接
 ESD に伴う電磁パルスの計測と解析",信学論(B-II),
 vol.J75-B-II, no.9, pp.647–654, Sept. 1992.
- [8] 馬杉正男,"電気ダイポールによる静電気放電の過渡応答 解析",信学論(B-II),vol.J75-B-II, no.12, pp.981–988, Dec. 1992.
- [9] 本田昌實,"静電気放電(ESD)現象の基本的な捉え方",
 第 31 回東北大学電気通信研究所シンポジウム「放電と EMC」, pp.79-86, 1994.
- [10] 藤原 修,張 小江,山中幸雄,"静電気試験法による放電 電流の FDTD シミュレーション",信学識 B), vol.J86-B, no.11, pp.2390–2398, Nov. 2003.
- [11] B. Daout and H. Ryser, "The reproducibility of the rising slope in ESD testing," Proc. 1986 IEEE Int'l Symp. on Electromagn. Compat., pp.467–474, Aug. 1986.
- [12] D. Pommerenke, "ESD: Waveform calculation, field and current of human and simulator ESD," J. Electrostatics, vol.38, pp.31–54, 1996.
- [13] 川又 憲,楊 心偉,芳賀 昭,佐藤利三郎,"電気接点 放電による高速過渡現象の分布定数系実験回路を用い た観測法の提案",信学論(B-II),vol.J72-B-II, no.10, pp.565-571, Oct. 1989.
- [14] K. Kawamata, S. Minegishi, A. Haga, and R. Sato, "A measurement of very fast transition durations due to gap discharge in air using distributed constant line system," IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol.41, no.2, pp.137-141, 1999.
- [15] 川又 憲,嶺岸茂樹,芳賀 昭,"1,500 V 以下の ESD に 伴う過渡電圧の立上り時間及び周波数スペクトルに関す る実験的検討",信学論(B),vol.J86-B, no.7, pp.1191– 1198, July 2003.
- [16] K. Kawamata, S. Minegishi, and A. Haga, "Wideband measurement of transition duration and frequency spectra due to small gap discharge as low voltage ESD," J. Electrostatics, vol.62, pp.185–193, 2004.

(平成 19 年 2 月 14 日受付, 6 月 11 日再受付)



川又 憲 (正員)

平元東北学院大大学院博士前期課程了. 同年4月東北電力(株)入社.平4年3月 同退職.同年4月八戸工業大・工・電気助 手,講師を経て平15同助教授.現在,環 境電磁工学に関連して電気接点放電及び ESD などによる放電雑音のメカニズム究

明並びに分布定数回路応用に関する研究に従事.工博.電気学会, ESDA, IEEE 各会員.



嶺岸 茂樹 (正員)

昭56東北学院大大学院博士後期課程了. 同年4月同大・工・電気助手,講師,助教 授を経て,平11同教授.現在,環境電磁 工学に関連して,電気接点開離時における 電磁雑音の過渡プロセス究明並びに分布定 数回路応用に関する研究に従事.工博.電

気学会,IEEE 各会員.

芳賀



昭45山形大大学院修士課程了.同年4月 シチズン時計技術研究所入所.昭47東北 学院大・工・電気助手,講師,助教授を経 て,平4同教授.現在,環境電磁工学に関 連して,磁気遮へいを中心とした磁気応用

工学及び低周波環境磁界測定技術などに関

する研究に従事.工博.電気学会,日本応用磁気学会,IEEE 各会員.

昭



藤原 修 (正員)

昭48名大大学院修士課程了.同年(株) 日立製作所中央研究所入所.昭51同所退 職.昭55名大大学院博士後期課程了.名 工大工学部助手,講師を経て,昭60同助 教授,現在,同教授.工博.平3~4スイ ス連邦工科大客員教授.放電雑音,生体電

磁環境,環境電磁工学に関連する研究に従事.昭55電気学会 論文賞,平12年度本会論文賞受賞.電気学会,IEEE 各会員.